

2SC2714 (3DG2714)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

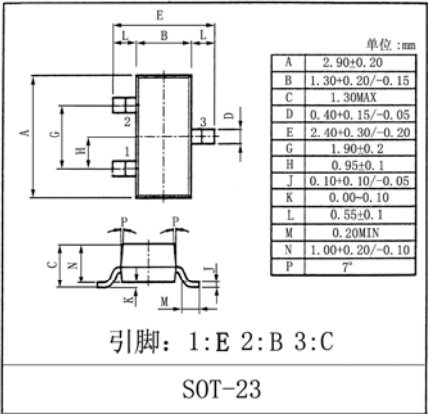
用途:用于高频放大。/Purpose: High frequency amplifier applications.

特点:反向传输电容小, 噪声系数低。

Features: Small reverse transfer capacitance, low noise figure.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	30	V
V_{EB0}	4.0	V
I_C	20	mA
I_E	-20	mA
P_C	100	mW
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
I_{CB0}	$V_{CB}=18V$ $I_E=0$			0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=4.0V$ $I_C=0$			0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$	40		200	
f_T	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$		550		MHz
G_{pe}	$V_{CE}=6.0V$ $I_E=-1.0mA$ $f=100MHz$	15	18		dB
NF	$V_{CE}=6.0V$ $I_E=-1.0mA$ $f=100MHz$		2.5	5.0	dB
$C_c . r_{bb}'$	$V_{CE}=6.0V$ $I_E=-1.0mA$ $f=30MHz$			30	ps
C_{re}	$V_{CE}=6.0V$ $f=1.0MHz$		0.70		pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	R	0	Y
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	40~80	70~140	100~200
印章 Marking	HQR	HQ0	HQY

